

⑩ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑪ Offenlegungsschrift  
⑪ DE 197 34 794 A 1

⑤ Int. Cl. 6:  
H 01 L 23/50  
H 01 L 23/495  
H 01 L 21/60

⑩ Aktenzeichen: 197 34 794.0  
⑩ Anmeldetag: 11. 8. 97  
⑩ Offenlegungstag: 16. 7. 98

DE 197 34 794 A 1

⑩ Unionspriorität

P 2310/97 09. 01. 97 JP

⑩ Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

⑩ Anmelder:

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

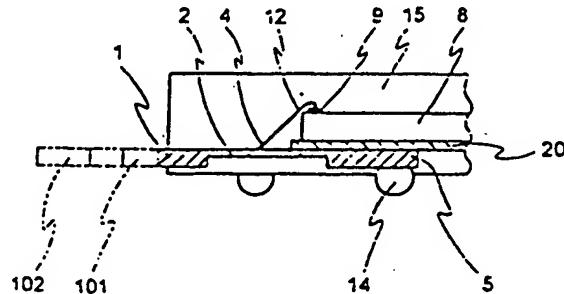
⑩ Vertreter:

Tiedtke, Bühlung, Kinne & Partner, 80336 München

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen  
Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤ Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

⑤ Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



DE 197 34 794 A 1

1  
Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung bei einer Halbleitervorrichtung und einen Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der höheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Umlaufbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Umlaufbreite von Halbleiterelementenlektroden, die an den Oberflächen von einer Halbleitervorrichtung bildenden Halbleiterelementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenlektroden, die beispielsweise auf der äußeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementenlektroden und der Außenlektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine gedruckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflächen der Halbleiterelemente vorgesehenen Halbleiterelementenlektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definiert werden, bei denen es sich um die Außenlektroden der Halbleitervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementenlektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenlektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definiert werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkömmliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelementes ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist, 11 eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete leitende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelementes 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldraht 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorgesehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nähe des Halbleiterelementes 8 angeordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mit dem an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschrift

258 048/1988 offenbarte herkömmliche Leiterplatte angewendet ist. Bei der Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelementes ausgebildete Halbleiterelementelektrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte der, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. Die Bezugszahl 11 bezeichnet eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete leitende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung, 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film); mit einem Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten leitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist, sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die leitende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der interne Verdrahtung 17 mit dem an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verbunden. Bei der in der japanischen Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement mit mehr Anschlüssen als das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarte Halbleiterelement 8 angebracht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der inneren Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie des TAB-Bands 19 angewandt wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Elektroden an den Oberflächen der Halbleiterelemente mit den Außenlektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupfersolie mit einer Dicke von 25 µm bis 75 µm bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenlektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Lötlöschung (eine Lötwölbung) oder der gleichen an der Oberfläche ausgebildet, die der Oberfläche gegenüberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterelemente angebracht sind, damit die Größe Halbleitervorrichtung verringert werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelementes ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättchen, an den das Halbleiterelement angebracht ist, 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplättchen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens, 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen dünnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4, 15 ein die Halbleiterelemente abdichtendes Vergußharz, 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung aufgebauten Elektrode, die an den zweiten Elektrodenabschnitt 5 durch Lötwinn 25 oder vergleichbare geführt ist.

Fig. 25 zeigt ein Schnittsicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterrahmens durch einen herkömmlichen Ätzvorgang. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dicke von 125 bis 200  $\mu$ m und 3 eine Ätzmaske mit einem vorherstimmten Muster, wobei dasselbe Muster auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahlungsabschnitt des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. Da der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125  $\mu$ m bis 200  $\mu$ m verwendet wird, muß der Abstand zwischen benachbarten Verdrahlungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdem ist zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210  $\mu$ m bis 250  $\mu$ m, was etwa doppelt so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömmlichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelementelektrode durch Drahtbunden verbundenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenabschnitt und des an eine externe Schaltung gelösten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts durch Ätzen und darauf folgendes Verkleinern des Verdrahlungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbar. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenbar ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 eine leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial handelt, 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersten Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Ätzmaske 3b weist eine Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Ätzmaske 3a eine Öffnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben auszubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Ätzmaske 3a geätzt wurde, und 24 eine Ätzwiderstandsschicht dar. Zunächst werden die Ätzmasken 3a und 3b an den Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der Ätzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verhindert wird, daß der Ätzvorgang weiter voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Ätzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzt, bis das Ätzen die Ätzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Ätzwiderstandsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittsicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150  $\mu$ m beträgt, wird die Dicke  $\overline{22}$  des ersten Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50  $\mu$ m, was eine Verkleinerung der Leiternunterteilungsbreite ermöglicht. Die Bezugszahl 23 stellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich um die Außenelektrode des Halbleiters vermittelt handelt, und 20 ein Be-

festigungsplatte, an das ein Halbleiterelement angebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschriften 216 524/1987 und 232 305/1994 sind Varianten zur Verringerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Ätzmasken 3 erwechselnd auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handelt, und zur Verkleinerung der Leiternunterteilungsbreite durch Vorschieben des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derartig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflächen zwischeneinander liegen, falls diese als Elektrode zur Verbindung mittels Drahtbunden mit dem Halbleiterelement verwendet wird, sich das natriumartige Bondelement zwischen den geätzten rechten Oberflächen und dem Halbleiterelement ab löst.

Wie vorsichtig beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte als Verdrahlungsseil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbleiterelementes (Halbleiterelementenelektroden) und einer kleineren Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordert das Durchgangsloch und das Blindloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahlungen verbinden, einen Bohrvorgang. Folglich ist das Problem auf, daß die Kosten der Halbleiterverarbeitung durch die Beschädigung des Bohrers, die Reinigung der gebrochenen Oberflächen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspangen und dergleichen erhöht werden.

Denngegenüber ist bei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrahlungsseil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Leiternunterteilungsbreite verkleinert, jedoch ist für die Außenlektroden der Halbleitervorrichtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahlungsabschnitt, der derselbe oder größer wie der herkömmliche ist, zwischen den ersten Elektrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden) mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich ist das Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loianschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleitervorrichtung zu erhalten.

Daher liegt der Erfund die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahlungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahlungsseils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahlungsseil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleiterelementes erreichen sowie die Verkleinerung und Kostenverminderung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mit einem derartigen Verdrahlungsseil geschaffen werden.

Diese Aufgabe wird durch die in den beigelegten Patentansprüchen dargelegten Maßnahmen gelöst.

Erfundungsgemäß wird ein Verdrahlungsseil geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelemente ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahlungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahlungsabschnitt aus einem plattenförmigen leitenden Körper ausgebildet sind und die Dicke der Verdrahlungsabschnitt nicht dicker als zehn

so dick wie der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrahtungsabschnitt kann an einer Oberfläche des plattenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein.

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte versprechen an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts können dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts dieselbe wie die des plattenförmigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Hälfte der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenförmigen leitenden Körpers beträgt geprüft werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungssteil geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelementen ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektrodenabschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verbindungsabschnitt aus einem plattenförmigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsabschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt der breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten ausgebildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenförmigen leitenden Körper durch Ätzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzvorgang unterzogen werden.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungssteilen versehen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenabschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkömmlicher Leiterrahmen angewendet ist.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömmlichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darstellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darstellt.

#### Erläuterungen

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschrieben:

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Leiterrahmens gemäß dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt, 4' der elektrisch über einer dünnen Metalldrähte oder dergleichen mit einer an der Oberfläche des Halbleiterelement 8 ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist, 5 einer zweiten Elektrodenabschnitt 5, bei dem es sich um eine mit einem externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenleiterdrähte des Halbleitervorrichtung handelt.

deit, die aus einem Leiterschluß hergestellt ist, 15 ein Ver-  
gussharz, 20 ein Befestigungsplättchen, an das das Halblei-  
terelement 8 angebracht ist, 101 eine Führungsschiene und  
102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvor-  
gang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel  
darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl  
3 Ätzmasken,  $T_1$  die Dicke der leitenden Metallplatte 1,  $T_2$   
die von der Oberfläche (rückwärtigen Oberfläche) der leitenden  
Metallplatte 1 gesetzte Dicke, an der die Verdrän-  
gungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind,  $T_2$  die Dicke der  
Verdrähungabschnitte, die durch Ätzen dünner ausgeführt  
werden, M1 ein Maskierungsmuster der Ätzmaske 3 zur  
Ausbildung der Verdrähungabschnitte 2 und M2 eine Öff-  
nung der Ätzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwis-  
chen den Verdrähungabschnitten 2. Das Bezugssymbol  
W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmu-  
ster M1 ausgebildeter, mittleren Abschnitts des Verdräh-  
ungabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich  
aufgrund der gekrümmten Seiten die Dicke kleiner als das Ma-  
skierungsmuster M1 ist. Das Bezugssymbol W2 bezeichnet  
den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Ver-  
drähungabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich auf-  
grund der gekrümmten Seiten größer als die Öffnung M2 ist. Die  
Bezugssymbole A und B bezeichnen Ätzgrenzflächen, die die  
Musiergrenzflächen an den durch Ätzen von der unteren  
Oberfläche des Verdrähungabschnitts 2, das heißt von den  
von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplatte  
1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird  
durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbestim-  
mten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte  
1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflächen gleich-  
zeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die  
leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die  
vorbestimmten Ätzenden A und B erhalten werden, und  
schließlich die Ätzmasken 3 entfernt werden. Dabei wird die  
Ätztiefe  $T_1$  von der rückwärtigen Oberfläche größer als die  
Hälfte der Dicke  $T$  der leitenden Metallplatte 1 und die  
Dicke  $T_2$  der Verdrähungabschnitte 2 kleiner als die Hälfte  
der Dicke  $T$  der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrähungabschnitte 2 lediglich  
an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, je-  
doch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrähungsar-  
schnitte 2a und die Verdrähungabschnitte 2b jeweils ab-  
wechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden  
Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Lei-  
terunterteilungsbreite verringert wird. Gemäß dieser Dar-  
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrähungabs-  
chnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 2b  
Verdrähungabschnitte für die zweite Seite der leitenden  
Metallplatte 1, M3 eine Öffnung für die Ätzmasken 3 zur  
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrähungabs-  
chnitten 2a oder zwischen den Verdrähungabschnitten 2b,  
die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1  
ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des  
Leiterrahmens gemäß diesem Ausführungsbeispiel. Da  
beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des  
zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wäh-  
rend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste  
Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenab-  
schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf.  
Obwohl eine Seite des ersten Elektrodenabschnitts 4 und  
des zweiten Elektrodenabschnitts 5 verbindenden Verdrän-  
gungsabschnitt 2 mit der Ätzmaske 3 während des Ätzver-  
gangs bedeckt ist, wird das Ätzen von der anderen Seite  
durchgeführt. Deshalb wird der Verdrähungabschnitt 2  
dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflächen  
(Anschlussoberflächen) 4a und 5a der ersten Elektrodenab-  
schnitte 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an densel-  
ben Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind, woh-  
ingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungs-  
oberflächen 4a und 4b an unterschiedlichen Seiten der leitenden  
Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des ersten  
Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenab-  
schnitts 5 nicht gesetzte Oberflächen der leitenden  
Metallplatte 1 sind, wird kein Problem beim Bönen verur-  
sacht. Deshalb können die Verbindungsoberflächen des ersten  
Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenab-  
schnitts 5 wie gewünscht ausgewählt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsbeispiel  
wird ein Ätzen von beiden Seiten der leitenden Metall-  
platte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrähungabschnitte 2  
nicht dicker als die Hälfte der Dicke der leitenden Metall-  
platte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter  
den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand  
W2 zwischen den Verdrähungabschnitten 2 oder der Ab-  
stand W3 zwischen den Verdrähungabschnitten 2a und 2b  
derselbe wie die Dicke  $T_2$  der Verdrähungabschnitte 2, 2a  
und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiteruntertei-  
lungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke  
 $T_2$  normalerweise ist, diese kleiner als die Dicke  $T$  der leitenden  
Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können die zweiten  
Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektro-  
denabschnitte 4, das heißt an der Rückseite des an dem Be-  
festigungsplättchen 20 angebrachten Halbleiterelementes 8  
angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halblei-  
tervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen  
durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Ver-  
drähungabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke  
 $T_2$  der Verdrähungabschnitte 2, indem die Dicke  $T_2$  der Verdrähungabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb  
kann die Leiterunterteilungsbreite verkürzt werden, wobei  
eine Feinverdrähung möglich wird. Zusätzlich kann, wenn  
die Verdrähungabschnitte 2a der ersten Seite der leitenden  
Metallplatte 1 und die Verdrähungabschnitte 2b der zweiten  
Seite der leitenden Metallplatte 1 abwechselnd angeord-  
net werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an un-  
terschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebil-  
deten Verdrähungabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ab-  
stand W2 der Verdrähungabschnitte 2 ausgeführt werden,  
wobei folglich die Leiterunterteilungsbreite weiter verklei-  
nert werden kann. Außerdem können die Verbindungsob-  
erflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten  
Elektrodenabschnitte 5 derart wie gewünscht bestimmt werden,  
daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelektro-  
den und der Außenlektroden der Halbleitervor-  
richtung erhöht wird.

#### Zweites Ausführungsbeispiel:

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten  
Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenab-  
schnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf.  
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwis-  
chen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derselben  
Weise wie die Verdrähungabschnitte 2 durch eine dünneren  
Ausführung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 mittels Ätzen  
von einer Seite bei dem Ätzvorgang verkleinert werden.

Gemäß Fig. 7 ist die Verbindungsoberfläche 5a der zweiten  
Elektrodenabschnitte 5 an der Seite vorgesehen, die nicht geatzt wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verbindungsfläche 5a des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gesetzten Seite vorzusehen, die Verbindungsfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 eben ausgeführt werden, was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Elektrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke  $T_1$ , eine Leiterbreite  $W_1$  und eine Verengungsgröße  $\Delta T_2$  aufweist,  $\Delta T_2$  gleich  $\epsilon T_2$ , wobei die erhöhte Leiterbreite gleich  $v \times (\Delta T_2/T_2) \times (W_1)$  wird, was anzeigen, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Pressvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um die roh geätzte Oberfläche eben auszuführen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

#### Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 wie die Verdrahlungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die nicht geätzte wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der gesetzten Seite vorzusehen, die Verbindungsfläche durch einen Pressvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verursacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Stiften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

#### Viertes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darstellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahlungsabschnitte, die durch Ätzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiterrahmens dünner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahlungsabschnitt 2a und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahlungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 bezeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsabschnitt zwischen dem Verdrahlungsabschnitt 2a an der ersten Seite und dem Verdrahlungsabschnitt 2b an der zweiten Seite, der bei Ausbildung des Leiterrahmens nicht festzusetzt wird, da beide Seiten mit Ausätzmasken bedeckt sind.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dünner ausgeführt, was eine Feinverdrahlung ermöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt ermöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahlungsabschnitts 2a an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahlungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidimensionale verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine Verdrahlung mit einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erreicht werden.

#### Fünftes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b darauf, daß sich die Richtung der Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel ändert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenkontakte der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzurichten.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 darin in jeder beliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenkontakte der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

#### Sechstes Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemäß Fig. 1 bezeichneten, entfällt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe beieinander liegen, kann zur Verdrahlung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-förmiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

#### Siebtes Ausführungsbeispiel

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine enge Länge der Linie C-C genommene Schnittansicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahlungsabschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten

Elektrodenabschnitt 5 an dessen ersten Seite ausgebildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Verdrahlungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenabschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemustert, der die Form des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahlungsabschnitt bzw. das Verdrahlungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist, 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel sind die Verdrahlungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahlungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahlungsabschnitt 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, damit die breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahlungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahlung mit einer höheren Dichte und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erreicht. 25

#### Achtes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahlungsabschnitte 2 30 überlappi. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahlungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahlungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorstehend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahlung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahlungsseil zur elektrischen Verbindung der Halbleitervorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kann durch Verwendung eines Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrahlungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unterteilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwärtigen Seite der Halbleiterelemente eine kleinere Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird ein Verdrahlungsseil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 4, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelementes 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahlungsabschnitt 2 geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahlungsabschnitt 2 sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper 1 ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahlungsabschnitts 2 nicht größer ist als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgeführt ist. Eine Feinverdrahlung kann dadurch erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahlungsseil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 9 mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird. 5

#### Patentansprüche

1. Verdrahlungsseil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelementes (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahlungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahlungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahlungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ist.

2. Verdrahlungsseil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahlungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plattenförmigen leitenden Körpers (1) vorgeschen ist.

3. Verdrahlungsseil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahlungsabschnitte (2) verteilt an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahlungsseil nach einem der Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahlungsseil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenförmigen leitenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahlungsseil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr als die Hälfte des plattenförmigen leitenden Körpers (1) beträgt, geprägt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahlungsseil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelementes (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahlungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahlungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts (2) ausgebildet ist,

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahlungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahlungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der

Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

8. Verdrahtungsteil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsabschnitt (6) ein Abschnitt ist, bei dem der Verdrahtungsabschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsabschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen.

9. Verdrahtungsteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zweiten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, daran angeordnet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenförmigen leitenden Körper (1) durch Ätzen ausgebildet ist.

11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungssteinen, wobei das Verdrahtungsstein einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterleimens (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode (3) elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungssteinen, wobei das Verdrahtungsstein einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterleimens (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist, wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierzu 12 Seiten (n) Zeichnungen

FIG. 1

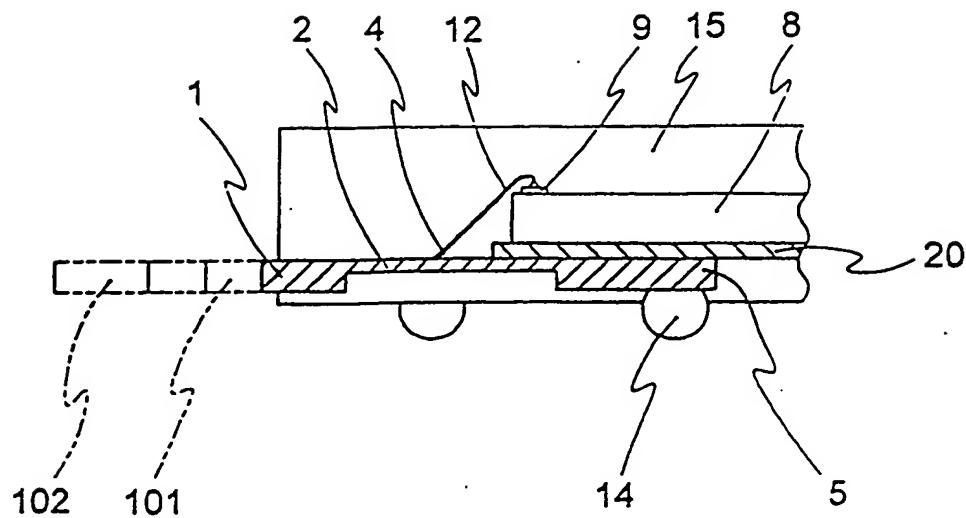
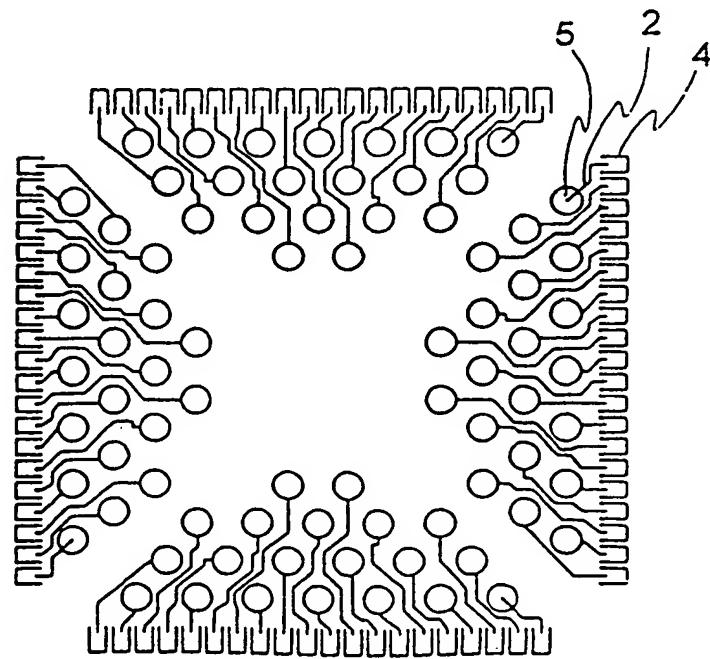
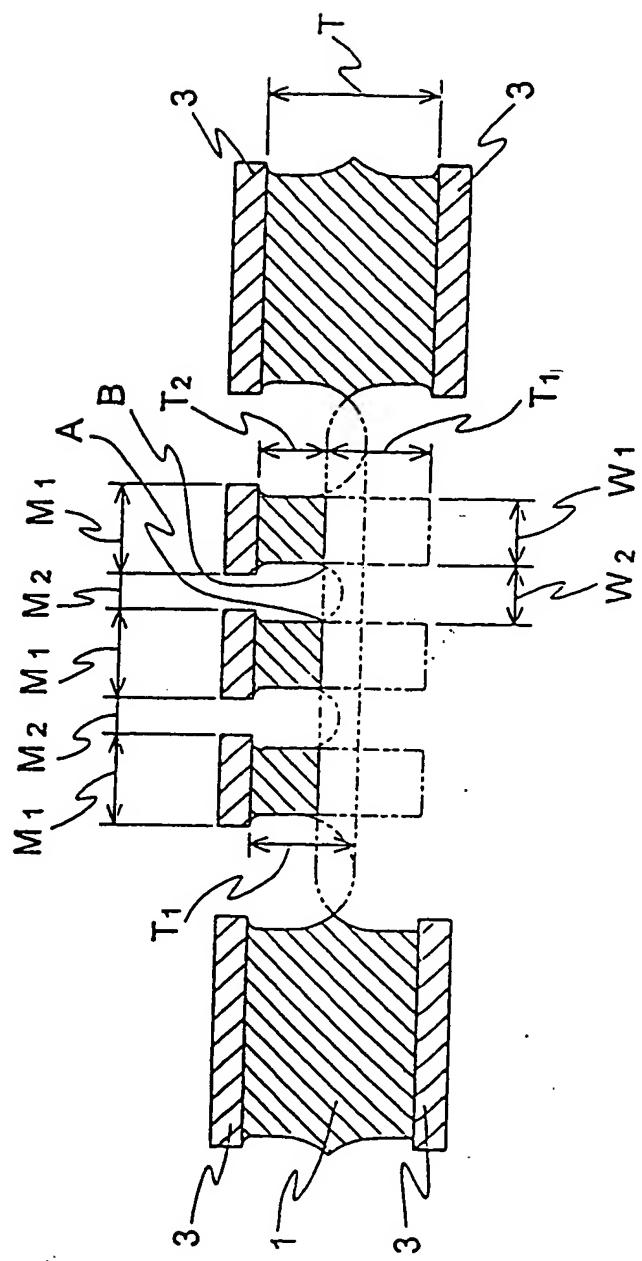


FIG. 2



E/G.3



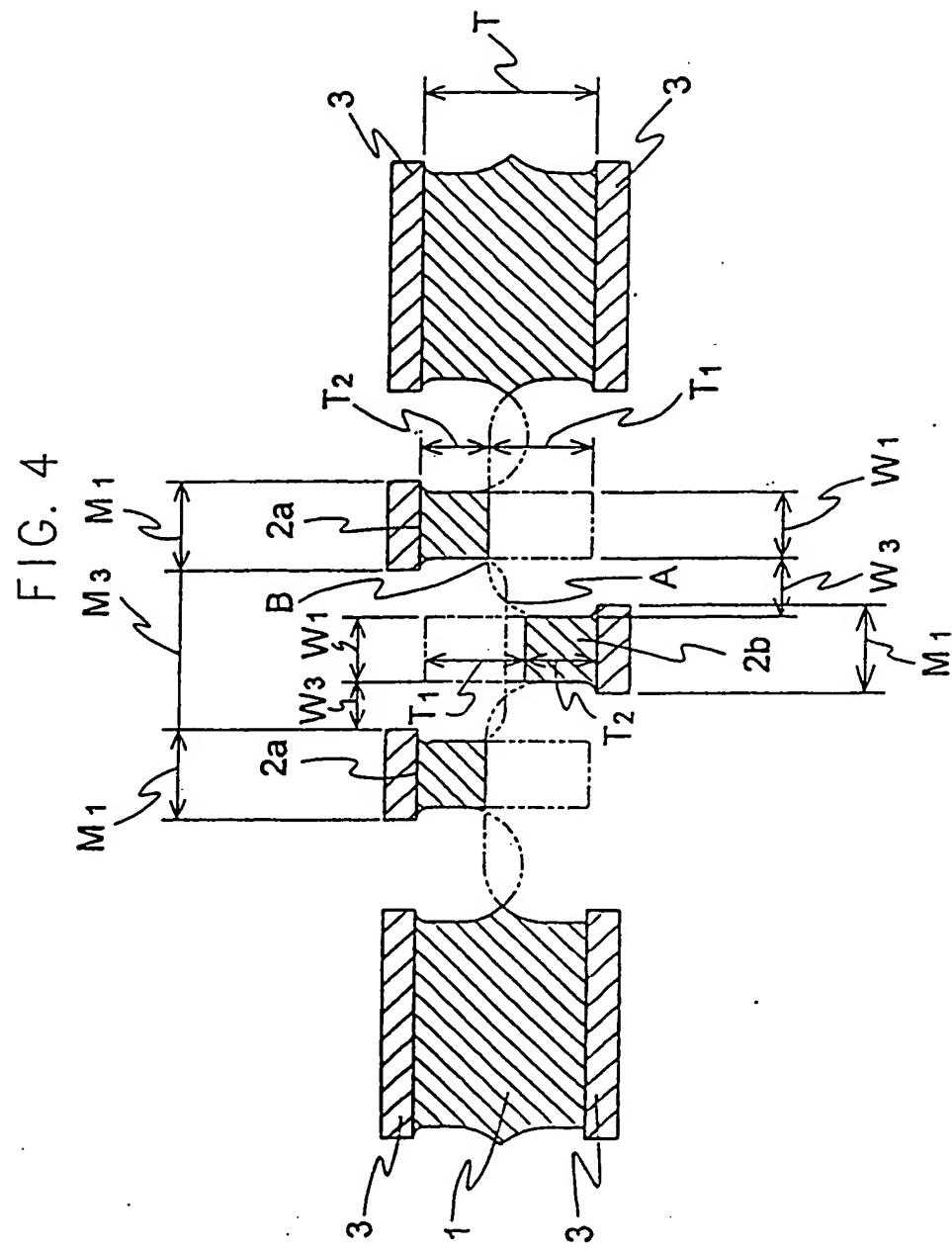


FIG. 5

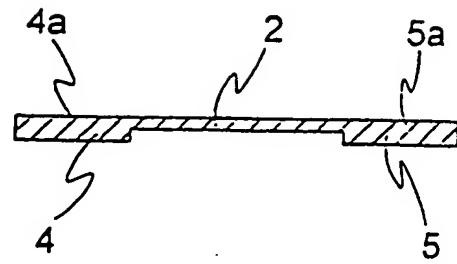


FIG. 6

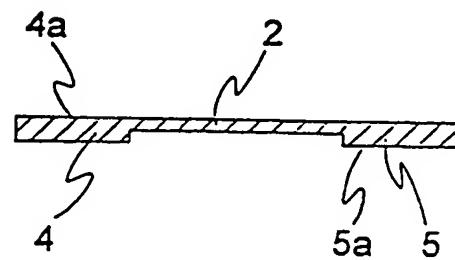


FIG. 7

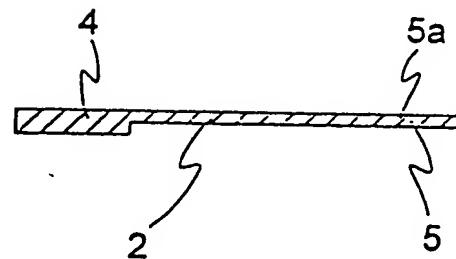


FIG. 8

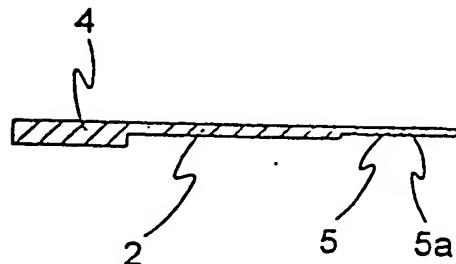


FIG. 9

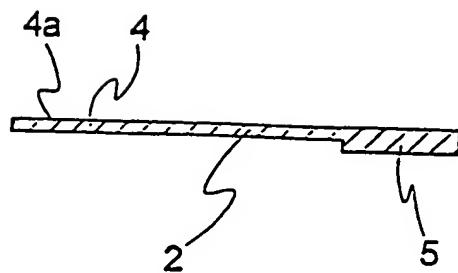


FIG. 10

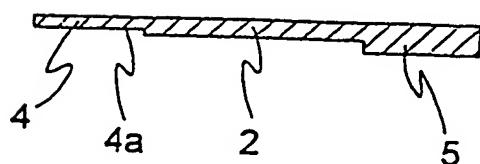


FIG. 11

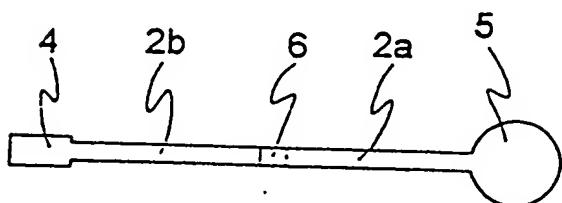


FIG. 12

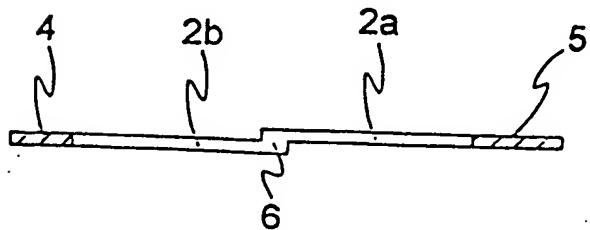


FIG.13

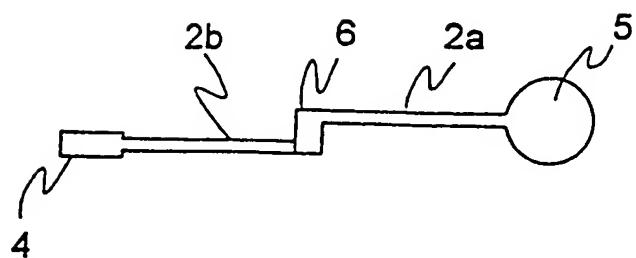


FIG.14

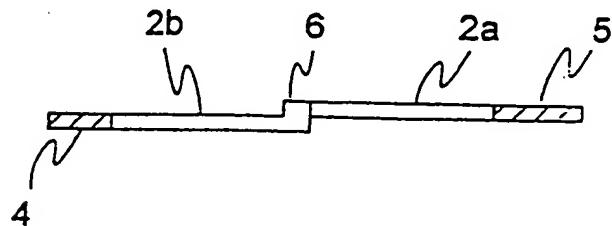


FIG.15

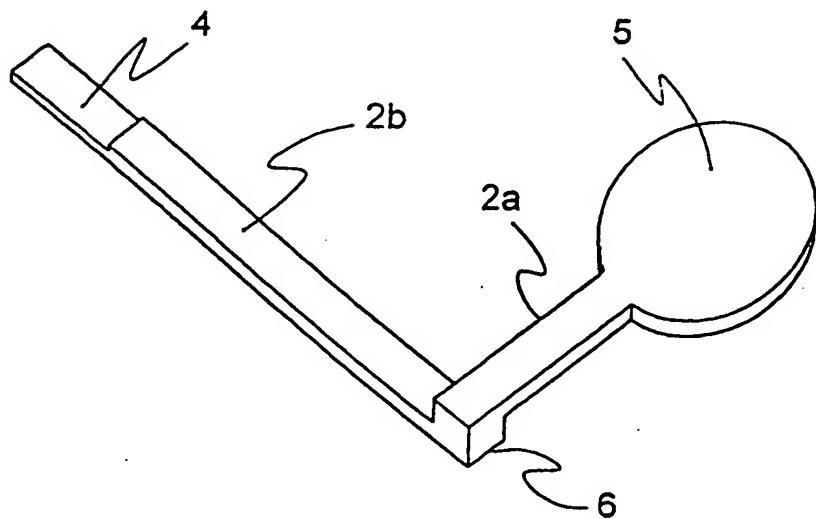


FIG. 16

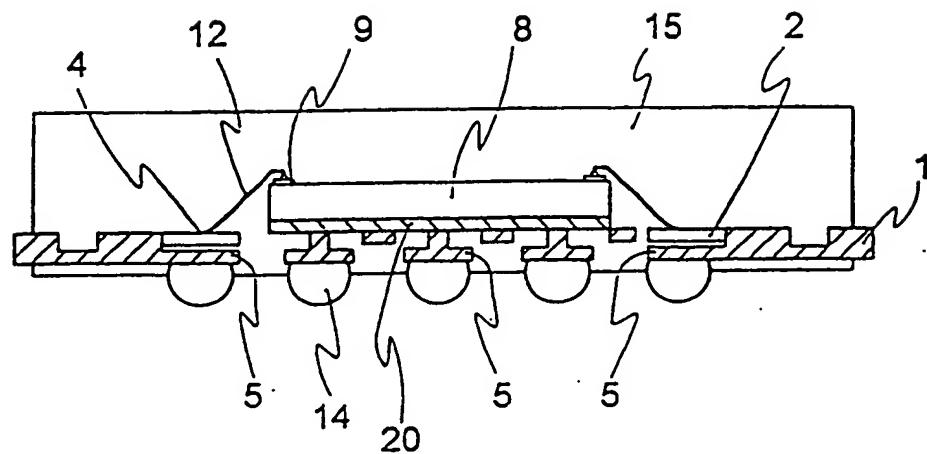


FIG. 17

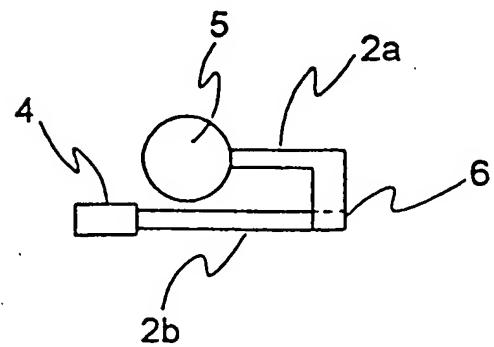


FIG.18

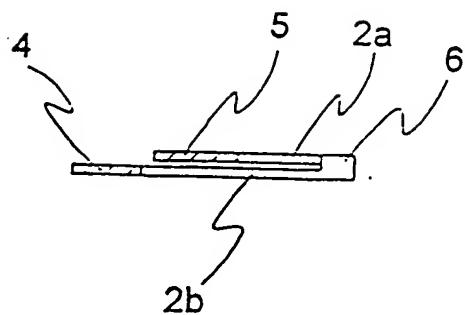


FIG.19

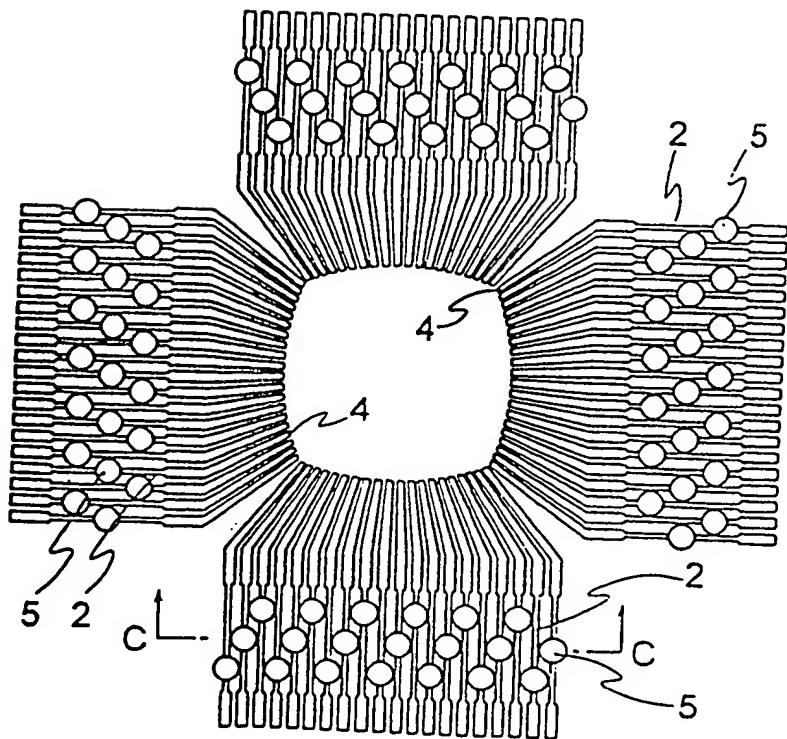


FIG. 20

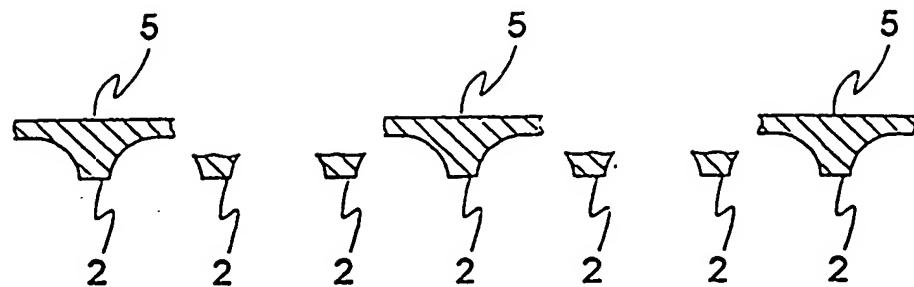


FIG. 21

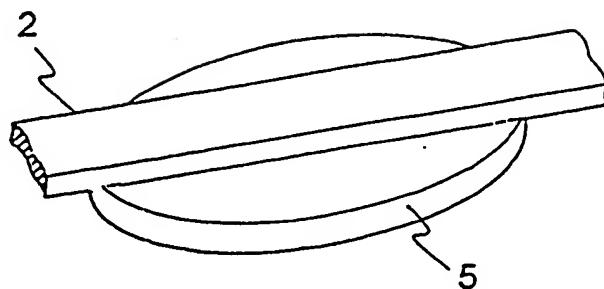
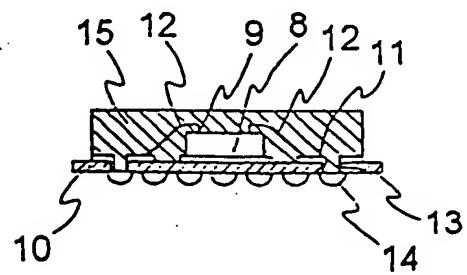
FIG. 22  
(STAND DER TECHNIK)

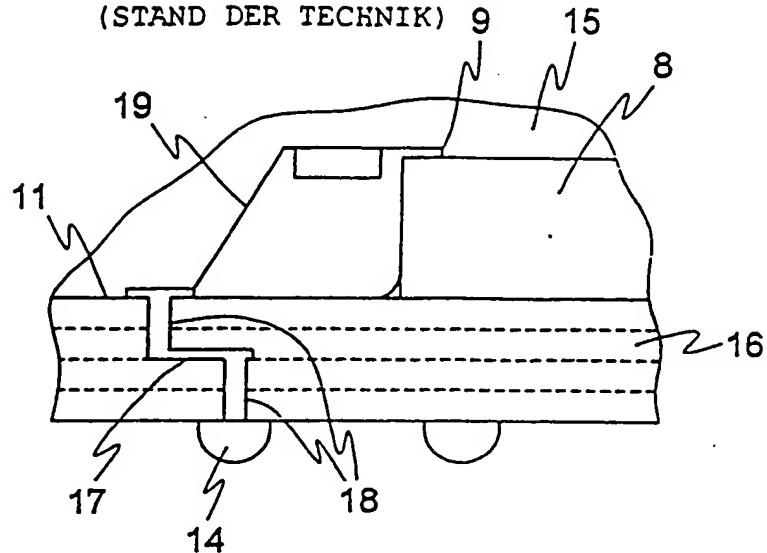
FIG. 23  
(STAND DER TECHNIK)

FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

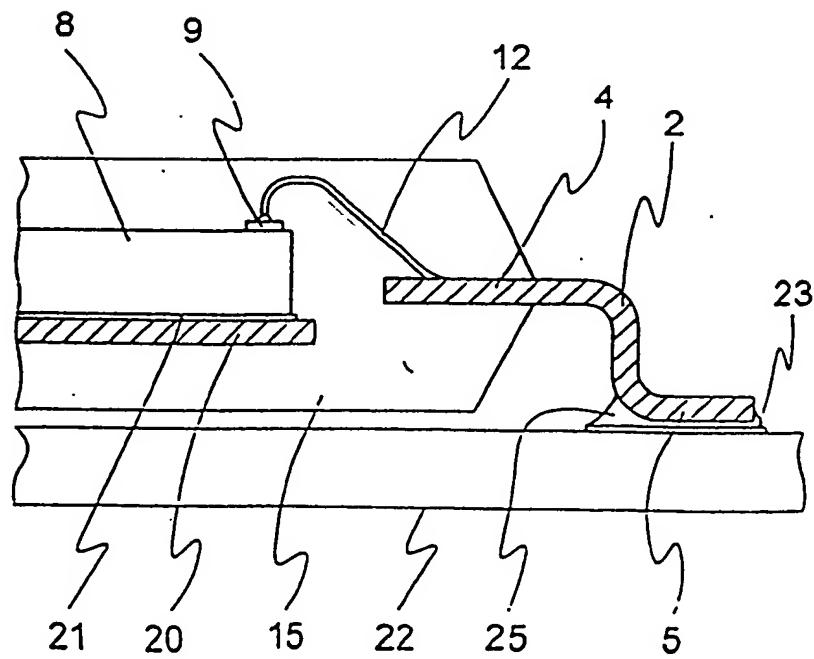


FIG. 25  
(STAND DER TECHNIK)

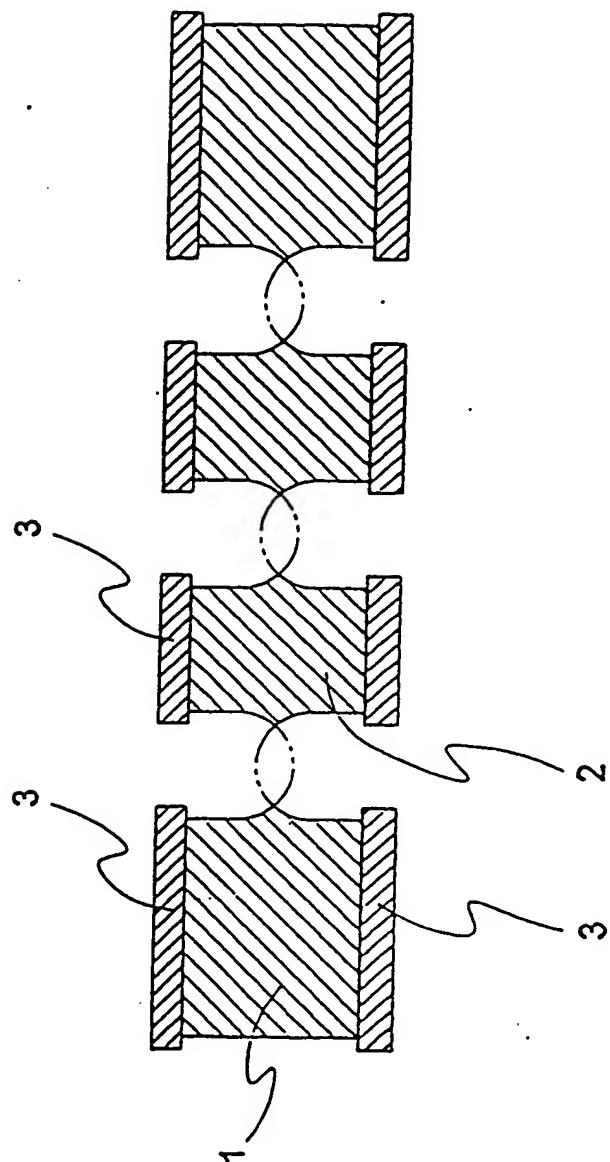


FIG. 26(a)

(STAND DER TECHNIK)

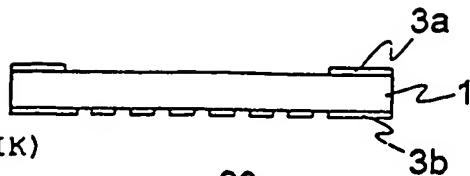


FIG. 26(b)

(STAND DER TECHNIK)

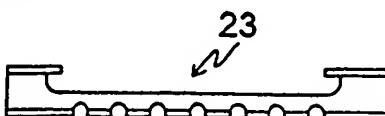


FIG. 26(c)

(STAND DER TECHNIK)

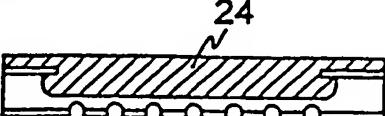


FIG. 26(d)

(STAND DER TECHNIK)



FIG. 26(e)

(STAND DER TECHNIK)

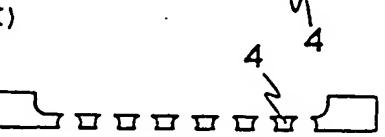


FIG. 27

(STAND DER TECHNIK)

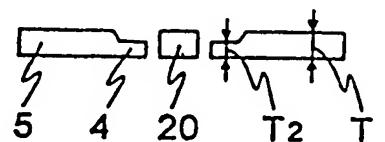


FIG. 28

(STAND DER TECHNIK)

